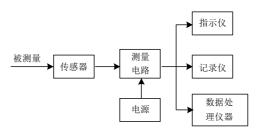
# 1. 检测系统由哪几部分组成? 说明各部分的作用。

答: 一个完整的检测系统或检测装置通常是由传感器、测量电路和显示记录装置等几部分组成,分 别完成信息获取、转换、显示和处理等功能。当然其中还包括电源和传输通道等不可缺少的部分。下图 给出了检测系统的组成框图。



检测系统的组成框图

传感器是把被测量转换成电学量的装置,显然,传感器是检测系统与被测对象直接发生联系的 部件,是检测系统最重要的环节,检测系统获取信息的质量往往是由传感器的性能确定的,因为检 测系统的其它环节无法添加新的检测信息并且不易消除传感器所引入的误差。

测量电路的作用是将传感器的输出信号转换成易于测量的电压或电流信号。通常传感器输出信 号是微弱的,就需要由测量电路加以放大,以满足显示记录装置的要求。根据需要测量电路还能进 行阻抗匹配、微分、积分、线性化补偿等信号处理工作。

显示记录装置是检测人员和检测系统联系的主要环节,主要作用是使人们了解被测量的大小或变化 的过程。

2. 某线性位移测量仪, 当被测位移由 4.5mm 变到 5.0mm 时, 位移测量仪的输出电压由 3.5V 减至 2.5V, 求该仪器的灵敏度。

解: 该仪器的灵敏度为

$$S = \frac{2.5 - 3.5}{5.0 - 4.5} = -2 \text{ mV/mm}$$

3. 某测温系统由以下四个环节组成,各自的灵敏度如下:

铂电阻温度传感器:

**0.45Ω/°**C

电桥:

 $0.02V/\Omega$ 

放大器:

100(放大倍数)

笔式记录仪:

0.2cm/V

- 求: (1)测温系统的总灵敏度:
  - (2) 记录仪笔尖位移 4cm 时,所对应的温度变化值。

解:

(1) 测温系统的总灵敏度为

$$S = 0.45 \times 0.02 \times 100 \times 0.2 = 0.18$$
 cm/°C

(2) 记录仪笔尖位移 4cm 时,所对应的温度变化值为

$$t = \frac{4}{0.18} = 22.22 \,^{\circ}\text{C}$$

4.有三台测温仪表,量程均为 0~800  $^{\circ}$  ,精度等级分别为 2.5 级、2.0 级和 1.5 级,现要测量 500  $^{\circ}$  的 温度,要求相对误差不超过2.5%,选那台仪表合理?

解: 2.5 级时的最大绝对误差值为 20  $\mathbb{C}$  , 测量 500  $\mathbb{C}$  时的相对误差为 4 % ; 2.0 级时的最大绝对误差 值为 16 °C,测量 500 °C 时的相对误差为 3.2 %; 1.5 级时的最大绝对误差值为 12 °C,测量 500 °C 时的 相对误差为2.4%。因此,应该选用1.5级的测温仪器。

#### 5. 什么是系统误差和随机误差?正确度和精密度的含义是什么?它们各反映何种误差?

答:系统误差是指在相同的条件下,多次重复测量同一量时,误差的大小和符号保持不变,或按照

一定的规律变化的误差。随机误差则是指在相同条件下,多次测量同一量时,其误差的大小和符号以不可预见的方式变化的误差。正确度是指测量结果与理论真值的一致程度,它反映了系统误差的大小,精密度是指测量结果的分散程度,它反映了随机误差的大小。

6. 某压力传感器的测量范围为  $0^{\sim}10 \text{MPa}$ ,校验该传感器时得到的最大绝对误差为 $\pm 0.08 \text{MPa}$ ,试确定该传感器的精度等级。

解:该传感器的精度为:

$$\delta_{\max} = \frac{\Delta_{\max}}{ = 2} \times 100\% = \frac{\pm 0.08}{10-0} \times 100\% = \pm 0.8\%$$

由于国家规定的精度等级中没有 0.8 级仪表,而该传感器的精度又超过了 0.5 级仪表的允许误差,所以,这只传感器的精度等级应定为 1.0 级。

根据仪表校验数据来确定仪表精度等级时,仪表的精度等级值应选不小于由校验结果所计算的精度值

7. 某测温传感器的测量范围为  $0^{\sim}1000$  ℃,根据工艺要求,温度指示值的误差不允许超过±7 ℃,试问应如何选择传感器的精度等级才能满足以上要求?

解:根据工艺要求,传感器的精度应满足:

$$\delta_{\text{max}} = \frac{\Delta_{\text{max}}}{\frac{1}{2}} \times 100\% = \frac{\pm 7}{1000 - 0} \times 100\% = \pm 0.7\%$$

此精度介于 0.5 级和 1.0 级之间,若选择精度等级为 1.0 级的传感器,其允许最大绝对误差为 ±10℃,这就超过了工艺要求的允许误差,故应选择 0.5 级的精度才能满足工艺要求。

根据工艺要求来选择仪表精度等级时,仪表的精度等级值应不大于工艺要求所计算的精度值

填空
<u>1.测量</u> 是借助 和,通过和,取得被测对象的某个量的大小或
符号;或者取得
另一变量)
3. 直接测量是从事先上读出被测量的大小。间接测量是利用与之
间的函数关系,先测出,再通过相应的函数关系,被测量的数值。(分度好的表盘;
被测量;某种中间量;计算出)
4. 直接测量方法中,又分,和。(零位法;偏差法;微差法)
<u>5.</u> 零位法是指与在比较仪器中进行,让仪器指零机构
,从而确定被测量等于。该方法精度。(被测量;已知标准量;比较;达到平衡(指
零);已知标准量;较高)
<u>6.</u> 偏差法是指测量仪表用相对于
精度一般不高。(指针、表盘上刻度线位移)
<u>7. 微差法</u> 是
测出。(零位法;偏差法;已知标准量;比较;偏差法)
8. 测量仪表指示值程度的量称为精密度。测量仪表指示值有规律地程度的量
称为准确度。(不一致;偏离真值)

**9**. 测量仪表的<mark>精确度</mark>简称\_\_\_\_\_,是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的总和,以测量误差的\_\_\_\_\_来表示。

(精度;精密度;准确度;相对值)

10. 显示仪表能够监测到被测量\_\_\_\_\_的能力称分辨力。(最小变化)

#### 第二章

# 1. 金属电阻应变片与半导体材料的电阻应变效应有什么不同?

答:金属电阻的应变效应主要是由于其几何形状的变化而产生的,半导体材料的应变效应则主要取决于材料的电阻率随应变所引起的变化产生的。

# 2. 直流测量电桥和交流测量电桥有什么区别?

答:它们的区别主要是直流电桥用直流电源,只适用于直流元件,交流电桥用交流电源,适用于所有电路元件。

3. 采用阻值为  $120\Omega$  灵敏度系数 K=2.0 的金属电阻应变片和阻值为  $120\Omega$  的固定电阻组成电桥,供桥电压为 4V,并假定负载电阻无穷大。当应变片上的应变分别为 1 和 1 000 时,试求单臂、双臂和全桥工作时的输出电压,并比较三种情况下的灵敏度。

解: 单臂时
$$U_0 = \frac{K \varepsilon U}{4}$$
,所以应变为 1 时 $U_0 = \frac{K \varepsilon U}{4} = \frac{4 \times 2 \times 10^{-6}}{4} = 2 \times 10^{-6}$ /V,应变为 1000 时

应 为 
$$U_0 = \frac{K \varepsilon U}{4} = \frac{4 \times 2 \times 10^{-3}}{4} = 2 \times 10^{-3} / \text{V}$$
; 双臂时  $U_0 = \frac{K \varepsilon U}{2}$ , 所以应变为 1 时

$$U_0 = \frac{K\varepsilon U}{2} = \frac{4\times2\times10^{-6}}{2} = 4\times10^{-6} \text{/V}, \text{ } \dot{\boxtimes} \mathfrak{B} \text{ } 1000 \text{ } \dot{\boxtimes} \dot{\boxtimes} U_0 = \frac{K\varepsilon U}{2} = \frac{4\times2\times10^{-3}}{2} = 4\times10^{-3} \text{ }$$

/V: 全桥时 $U_0=K\varepsilon U$ ,所以应变为 1 时 $U_0=8\times 10^{-6}$  /V,应变为 1000 时应为 $U_0=8\times 10^{-3}$  /V。从上面的计算可知:单臂时灵敏度最低,双臂时为其两倍,全桥时最高,为单臂的四倍。

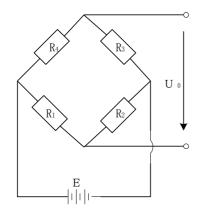
4. 采用阻值 R=120 $\Omega$  灵敏度系数 K=2.0 的金属电阻应变片与阻值 R=120 $\Omega$  的固定电阻组成电桥,供 桥电压为 10V。当应变片应变为 1000 时,若要使输出电压大于 10mV,则可采用何种工作方式(设输出阻抗为无穷大)?

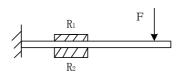
解:由于不知是何种工作方式,可设为n,故可得:

$$U_0 = \frac{K\varepsilon U}{n} = \frac{2\times 10\times 10^{-3}}{n} \hbar \ 10 \text{ mV}$$

得 n 要小于 2, 故应采用全桥工作方式。

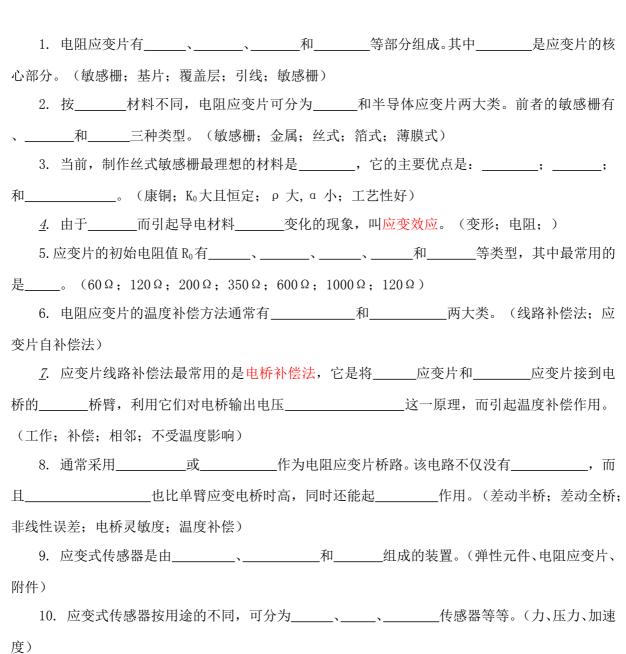
5. 如图所示为一直流电桥,供电电源电动势 E=3V,  $R_3=R_4=100\Omega$ ,  $R_1$ 和  $R_2$ 为同型号的电阻应变片,其电阻均为  $50\Omega$ ,灵敏度系数 K=2.0。两只应变片分别粘贴于等强度梁同一截面的正反两面。设等强度梁在受力后产生的应变为  $5\,000$ ,试求此时电桥输出端电压  $U_0$ 。





颞6图

解: 此电桥为输出对称电桥,故 $U_0=\frac{K\varepsilon U}{2}=\frac{2\times 3\times 5\times 10^{-3}}{2}=15\,\mathrm{/mV}$ 



# <u>1.</u> 试分析变面积式电容传感器和变间隙式电容的灵敏度?为了提高传感器的灵敏度可采取什么措施并应注意什么问题?

答:如图所示是一直线位移型电容式传感器的示意图。

当动极板移动△x 后,覆盖面积就发生变化,电容量也随之改变,其值为

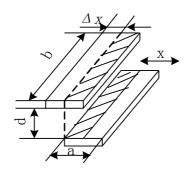
$$C = \varepsilon b (a - \Delta x) / d = C_0 - \varepsilon b \cdot \Delta x / d$$
 (1)

电容因位移而产生的变化量为

$$\Delta C = C - C_0 = -\frac{\varepsilon b}{d} \Delta x = -C_0 \frac{\Delta x}{a}$$

其灵敏度为  $K = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{\varepsilon b}{d}$ 

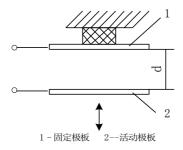
可见增加 b 或减小 d 均可提高传感器的灵敏度。



直线位移型电容式传感器

#### 2. 为什么说变间隙型电容传感器特性是非线性的?采取什么措施可改善其非线性特征?

答:下图为变间隙式电容传感器的原理图。图中 1 为固定极板,2 为与被测对象相连的活动极板。当活动极板因被测参数的改变而引起移动时,两极板间的距离 d 发生变化,从而改变了两极板之间的电容量 C。



设极板面积为A,其静态电容量为 $C = \frac{\varepsilon A}{d}$ ,当活动极板移动x后,其电容量为

$$C = \frac{\varepsilon A}{d - x} = C_0 \frac{1 + \frac{x}{d}}{1 - \frac{x^2}{d^2}} \tag{1}$$

当 x<<d 时

$$1 - \frac{x^2}{d^2} \approx 1 \quad \text{If } C = C_0 (1 + \frac{x}{d})$$
 (2)

由式(1)可以看出电容量 C 与 x 不是线性关系,只有当 x << d 时,才可认为是最近似线形关系。同时还可以看出,要提高灵敏度,应减小起始间隙 d 过小时。但当 d 过小时,又容易引起击穿,同时

加工精度要求也高了。为此,一般是在极板间放置云母、塑料膜等介电常数高的物质来改善这种情况。在实际应用中,为了提高灵敏度,减小非线性,可采用差动式结构。

1. 按工作原理的	的不同,电容式 <sup>/</sup>	传感器可分为		_、和	三种类型。
第一种常用于测量	<u>,</u>	第二种常用于测量_		,第三	种常用于测量
。(变间隙式;变面	积式;变介电常	了数式; 微小位移; ;	角位移或较大的	线位移;物位	)
2. 变间隙式店容	字传感器的初始的	间隙 d₀越小,传感器	器的灵敏度 K₀	_、非线性误差	ξγο, 以
上说明,提高 K <sub>0</sub> 与凋	【小γ <sub>0</sub> 。ī	生实际应用中,为使	传感器具有足够	8大的 K₀值,迫	通常使,
如果还必须使70具有	<b></b> <b>耳足够小的值,</b> !	则还应满足	,这就是它只	只能用于测量_	的原
理。(越大;越大;	相矛盾;d₀减小	$;  \left  \frac{\Delta d}{d_0} \right  / \gamma,  \Delta d_0 / \gamma;$	微小线位移)		
3. 解决变间隙式	戊电容传感器提高	高 K <sub>0</sub> 与非线性误差2	(a) 间的矛盾,可	采用	电容传感器,
后者与前者相比,不	「仅灵敏度	,而且非线性设	吴差也。	。但是,它还有	受电容极板间
的限制,为此,常采	用	的变间隙式电容传	感器。(差动式	公; 提高一倍;	降低;击穿电
压;部分固体介质)					
4. 变面积式电容	<b>容传感器的电容</b>	增量 ΔC 与动极板位	互移量 ΔX 的关系		ΔX,其
灵敏度 $K = \frac{\Delta C}{\Delta X} = $	。因此	,该传感器具有_	输出特	-性,即具有》	则量线位移的
和灵敏度 K 为	等优点。(	$\frac{b\varepsilon}{d}$ ; $\frac{b\varepsilon}{d}$ ; 线性; $\dot{\gamma}$	5围大,稳定常数	数)	
5极	板长度、	极板间间隙、选分	个电常数	_介质,都可以	提高变面积式
电容式传感器的灵敏	度。另外,采用	]的变面	积式电容传感器	, 也可以达到	提高灵敏度的
目的。(增加;减小	; 高; 齿形极板	Ž			

#### 第四章

# 1.影响差动变压器输出线性度和灵敏度的主要因素是什么?

答:影响差动变压器输出线性度和灵敏度的主要因素是:传感器几何尺寸、线圈电气参数的对称性、磁性材料的残余应力、测量电路零点残余电动势等。

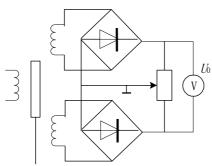
# 2. 电涡流式传感器的灵敏度主要受哪些因素影响?它的主要优点是什么?

答: 电涡流式传感器的灵敏度主要受导体的电导率、磁导率、几何形状,线圈的几何参数,激励电流频率以及线圈到被测导体间的距离等因素影响。电涡流式传感结构简单、频率响应宽、灵敏度高、

测量范围大、抗干忧能力强,特别是有非接触测量的优点,因此在工业生产和科学技术的各个领域中得到了广泛的应用。

# 3. 如图所示为一差动整流电路,试分析电路的工作原理。

答:这是简单的电压输出型,动铁芯移动时引起上下两个全波整流电路输出差动电压,中间可调整零位,输出电压与铁芯位移成正比。这种电路由二极管的非线性影响以及二极管正向饱和压降和反向漏电流的不利影响较大。



1. 螺线管式差动变压器主要由、、和和三部分组成。
(线圈组合;活动衔铁;导磁外壳)
2. 螺线管式差动变压器的线圈绕组按排列方式的不同可分为、、、、以及
等类型,通常采用的是和。(一节式;二节式;三节式;四节式;五节式;二节式;
三节式)
3. 差动变压器在输出电压称为零点残余电压,其频谱主要包括和。该
电压会造成传感器再零点附近的灵敏度、分辨率和测量误差。(基波;高次谐
波;降低;变差;增大)
4. 差动整流式差动变压器常用的,它是先把差动变压器两各次级线圈的分别
整流,再将整流后的电流成通路差动输出。(测量电路;互感电势;串接)
5. 基于法拉第电磁感应现象,块状金属导体置于磁场中或在磁场中的作运
动时,导体将产生呈的感应电流,此电流叫电涡流。(变化着;切割磁力线;涡旋状)
6. 电涡流式传感器测量系统由和
实现测试任务。(传感器;被测体;磁场耦合程度)
7. 当利用电涡流式传感器测量位移时,只有在 x/r <sub>as</sub> =的范围内,才能得到较好的
和较高的。(0.05-0.15;线性;灵敏度)
8. 填写下表:

电感式传感器类型	工作原理
变隙式	间隙变化±δ时,引起气隙磁阻的改变,导致
	线圈电感的变化
差动变压器式	被测非电量的变化,导致线圈互感的变化,其

	原理为变压器原理
电涡流式	利用电涡流效应原理

#### 第五章

# 1. 为什么说压电式传感器只适用于动态测量而不能用于静态测量?

答:因为压电式传感器是将被子测量转换成压电晶体的电荷量,可等效成一定的电容,如被测量为静态时,很难将电荷转换成一定的电压信号输出,故只能用于动态测量。

2. 压电式传感器测量电路的作用是什么?其核心是解决什么问题?

答:压电式传感器测量电路的作用是将压电晶体产生的电荷转换为电压信号输出,其核心是要解决微弱信号的转换与放大,得到足够强的输出信号。

3. 一压电式传感器的灵敏度  $K_1$ =10pC / MPa,连接灵敏度  $K_2$ =0.008V / pC 的电荷放大器,所用的笔式记录仪的灵敏度  $K_3$ =25mm / V,当压力变化  $\Delta p$ =8MPa 时,记录笔在记录纸上的偏移为多少?解:记录笔在记录纸上的偏移为

解:记录笔在记录纸上的偏移为 $S=10\times0.008\times25\times8=16$ mm
1. 石英晶体和压电陶瓷多晶体具有、效应,利用它们的效应制成了电势
型传感器。(正; 逆压电; 正压电)
2. 石英晶体的右旋直角坐标系统中, Z 轴称, 该方向上 压电效应; X
轴称,
(光轴(中性轴);没有;电轴;垂直于 X 轴;最显著;机械轴;受力面上不产生电荷)
3. 沿石英晶片 X 轴加力,在力作用的上,产生电荷,承纵向压电效应。石英晶
体压电式传感器中主要用效应。它的特点是晶面上产生的与呈正比,
而与和无关。(两晶面;异性;纵向压电;电荷密度;作用在晶面上压强;晶片
厚度;面积)
4. 若沿石英晶体 Y 轴方向加压力,在
只是相反,称横向压电效应。(受力的两个晶面上;沿X轴加压力的两个晶面;电荷符
号)
5. 压电陶瓷是一种人工制造的压电材料,它是由无数细微的单晶组成,他们都有自发形成
的。压电陶瓷又叫。(多晶;单晶;极化方向;铁电体)
6. 极化处理前的压电陶瓷材料对外不显,各向,不具有。(极化
方向; 同性; 压电特性)
7. 极化处理后的压电陶瓷受到沿的作用力时,其随之改变,因而
在的平面上将出现电荷量的。它的大小与压电陶瓷的和的大小
成正比。(极化方向;剩余极化强度;垂直于极化方向;变化;压电系数;压力)
8. 压电陶瓷的压电系数比石英晶体的。所以采用压电陶瓷制作的压电是传感器,其
较高。但石英晶体的性是其他压电材料无法比的。(大得多;灵敏度;稳定)

- •	丛电元件是 <sup>−</sup>	一个电压很大的	信号源,它可以	等效一个	和一个	_并联的等效	电路。
测量中	要求与其它配接	接的放大器具有		_和	。(电荷源;	电容; 高输	入阻
抗; 低转	渝出阻抗)						
10.	电荷放大器是	是一个	,高放大倍	音数的	,其输出	出电压与压电	元件
和	有关。	(电容负反馈;	运算放大器;产	生的电荷;反	(馈电容)		
11.	压电式传感	器中,常把两	i片	的压电片 <b>叠</b> 在	一起,其并联	法是两压电	片的
粘贴在-	一起,	在两边电极	,增加	一倍,电容也	」增加一倍; 其串	以联接法是两	压电
			,增加 下两极板的电荷 <b>』</b>				
片的	粘在一	起,因而上、		<b>量与相</b>	同,总容量为	一半,	
片的 电压	粘在一 。(同型	起,因而上、 <sup>-</sup> <sup>过</sup> 号;负极;正	下两极板的电荷量	量与相 正极和负极;	同,总容量为 单片;单片时;	一半, 增大一倍)	输出

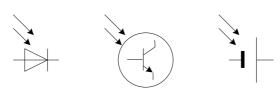
#### 第六章

#### 1. 光电效应有哪几种?与之对应的光电元件各有哪些?

答:光电效应有外光电效应、内光电效应和光生伏特效应三种。基于外光电效应的光电元件有光电管、光电倍增管等;基于内光电效应的光电元件有光敏电阻、光敏晶体管等;基于光生伏特效应的光电元件有光电池等。

# 2. 常用的半导体光电元件有哪些?它们的电路符号如何?

答: 常用的半导体光电元件有光敏二极管、光敏三极管和光电池三种。 它们的电路符号如下图所示:



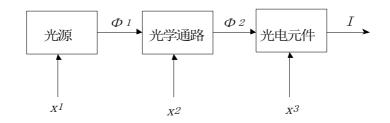
光敏二极管 光敏三极管 光电池

# 4. 什么是光电元件的光谱特性?

答: 光电元件的光谱特性是指入射光照度一定时,光电元件的相对灵敏度随光波波长的变化而变化,一种光电元件只对一定波长范围的人射光敏感,这就是光电元件的光谱特性。

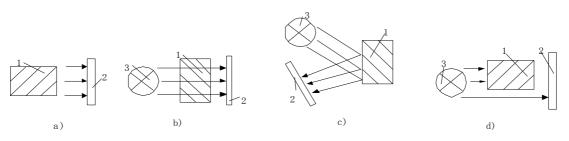
# 5. 光电传感器由哪些部分组成?被测量可以影响光电传感器的哪些部分?

答: 光电传感器通常由光源、光学通路和光电元件三部分组成,如图所示。图中  $\Phi_1$ 是光源发出的光信号, $\Phi_2$ 是光电器件接受的光信号,被测量可以是  $\mathbf{x}_1$ 或者  $\mathbf{x}_2$ ,它们能够分别造成光源本身或光学通路的变化,从而影响传感器输出的电信号  $\mathbf{I}$ 。



#### 6. 模拟式光电传感器有哪几种常见形式?

答:模拟式光电传感器主要有四种。一是光源本身是被测物,它发出的光投射到光电元件上,光电 元件的输出反映了光源的某些物理参数,如图 a 所示。这种型式的光电传感器可用于光电比色高温 计和照度计; 二是恒定光源发射的光通量穿过被测物, 其中一部分被吸收, 剩余的部分投射到光电 元件上,吸收量取决于被测物的某些参数。如图 b 所示。可用于测量透明度、混浊度; 三是恒定光源 发射的光通量投射到被测物上,由被测物表面反射后再投射到光电元件上,如图 c 所示。反射光的 强弱取决于被测物表面的性质和状态,因此可用于测量工件表面粗糙度、纸张的白度等;四是从恒 定光源发射出的光通量在到达光电元件的途中受到被测物的遮挡,使投射到光电元件上的光通量减 弱,光电元件的输出反映了被测物的尺寸或位置。如图 d 所示。这种传感器可用于工件尺寸测量、振 动测量等场合。



a) 被测量是光源 b) 被测量吸收光通量 c)被测量是有反射能力的表面 d) 被测量遮蔽光通量 1-被测物 2-光电元件 3-恒光源

# 7. 光敏电阻有哪些重要特性,在工业应用中是如何发挥这些特性的?

答: 光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。它的重要特性是在无光照

的变化来各种电路的控		1)阻阻艾特很小	<b>、相当</b> 丁.	<b>胆</b> 岭。	.业沙州	<b>中土安</b> 机	走进以	兀
1			半导	体上,		的	]现象,	称
为光生伏特效应。(镀	有金属膜; 相挂	接触的两种不同	]类型; 受	光照射产生	电动势	)		
2. 光电池是基于	直	妾将转换	成的	一种有源器	条件。(	光生伏特	较应;	光
能; 电能)								
3. 硅光电池的光谱	比硒大。征	之的光照度与短	5路电流的	关系呈	,	光照度与	i开路电	.压
的关系有。	使用硅光电池值	<b>刘量变换元件</b>	时,最好作	使其工作在			_。它在	:温
度特性是指	_与	_随	_的特性。	(光波长;	线性;	饱和期;	接近短	路
工作状态;短路电流;	开路电压;温	度变化)						

# 第七章

#### 1. 什么是金属导体的热电效应?试说明热电偶的测温原理。

答: 热电效应就是两种不同的导体或半导体 A 和 B 组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,回路中就会产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。热电偶测温就是利用这种热电效应进行的,将热电偶的热端插入被测物,冷端接进仪表,就能测量温度。

#### 2. 试分析金属导体产生接触电动势和温差电动势的原因。

答: 当A和B两种不同材料的导体接触时,由于两者内部单位体积的自由电子数目不同(即电子密度不同),因此,电子在两个方向上扩散的速率就不一样。现假设导体A的自由电子密度大于导体B的自由电子密度,则导体A扩散到导体B的电子数要比导体B扩散到导体A的电子数大。所以导体A失去电子带正电荷,导体B得到电子带负电荷,于是,在A、B两导体的接触界面上便形成一个由A到B的电场。该电场的方向与扩散进行的方向相反,它将引起反方向的电子转移,阻碍扩散作用的继续进行。当扩散作用与阻碍扩散作用相等时,即自导体A扩散到导体B的自由电子数与在电场作用下自导体B到导体A的自由电子数相等时,便处于一种动态平衡状态。在这种状态下,A与B两导体的接触处就产生了电位差,称为接触电动势。对于导体A或B,将其两端分别置于不同的温度场 t、t<sub>0</sub>中(t>t<sub>0</sub>)。在导体内部,热端的自由电子具有较大的动能,向冷端移动,从而使热端失去电子带正电荷,冷端得到电子带负电荷。这样,导体两端便产生了一个由热端指向冷端的静电场。该电场阻止电子从热端继续跑到冷端并使电子反方向移动,最后也达到了动态平衡状态。这样,导体两端便产生了电位差,我们将该电位差称为温差电动势。

#### 3. 简述热电偶的几个重要定律,并分别说明它们的实用价值。

答:一是匀质导体定律:如果热电偶回路中的两个热电极材料相同,无论两接点的温度如何,热电动势为零。根据这个定律,可以检验两个热电极材料成分是否相同,也可以检查热电极材料的均匀性。

- 二是中间导体定律:在热电偶回路中接入第三种导体,只要第三种导体的两接点温度相同,则 回路中总的热电动势不变。它使我们可以方便地在回路中直接接入各种类型的显示仪表或调节器, 也可以将热电偶的两端不焊接而直接插入液态金属中或直接焊在金属表面进行温度测量。
- 三是标准电极定律:如果两种导体分别与第三种导体组成的热电偶所产生的热电动势已知,则由这两种导体组成的热电偶所产生的热电动势也就已知。只要测得各种金属与纯铂组成的热电偶的热电动势,则各种金属之间相互组合而成的热电偶的热电动势可直接计算出来。

四是中间温度定律: 热电偶在两接点温度 t、 $t_0$ 时的热电动势等于该热电偶在接点温度为 t、 $t_n$ 和  $t_n$ 、 $t_0$ 时的相应热电动势的代数和。中间温度定律为补偿导线的使用提供了理论依据。

 $\underline{4.}$ 已知镍铬-镍硅(K)热电偶的热端温度 t=800℃,冷端温度 t₀=25℃,求 E(t,to)是多少毫伏? 镍铬-镍硅热电偶分度表查得 E(800,0)=33.275mV,E(25,0)=1.024 mV

解:由镍铬-镍硅热电偶分度表可查得 E(800,0)=33.275mV, E(25,0)=1.024 mV, 故可得 E(800,25)=33.275-1.024=32.251mV

5. 如图 5.14 所示之测温回路,热电偶的分度号为 K,毫伏表的示值应为多少度? 答:毫伏表的示值应为 $(t_1-t_2-60)^{\circ}$ C。

1.	热电偶是用	组成	而成。	。当两个	处于		]路
中便产	生。(	两种不同半导体或	金属;闭合电路;	; 结点; 不同	同温度时;	热电动势)	
2.	热电势的大小仅与_	的性质和	П	有关。热电势	势由	和温	差
电动势	两部分组成。(导体	材料;接触点温度	;接触电动势)				
3.	热电偶有两个	极。测温时,置于社	皮测温度场中的控	接点称	,置于	恒定温度场	ή中
的接占	称 . (执由.	执端(武丁作端.	测量端), 冷端	計(武参老端	. 白由端)		

	4.	接触电势是互相利用的两种金属	中,由于		不同	,引起_		产
生的	l。_	的金属,因		_宏观上带正	电;	_的金属,	因	_宏观
上带	负	电。(导体自由电子密度;自由电	子扩散;	电子浓度大;	扩散失去电子	子; 电子	浓度小;	得到
电子	<del>.</del> )							
	5.	温差电势是由于金属		起	而形成的。_		的一端	片为正
极,		的一端为负极。温差电	势一般比	接触电势小得	身多。(两端温)	度不同;	热扩散;	温度
高;	温力	度低)						
	6.	由A、B导体组成的热电偶,当引	入第三导	体C时,只要	至		_,则 C 長	异体的
接入	.对	回路无影响,这就	是中间导	·体定律。(「	中间导体的两의	耑温度相	同;总热	热电动
势)								
	7.	如果导体 C 分别与热电偶两	可个热电	.极 A、B组	成热电偶,	且保持	三个热	电偶
分别	相	司时,则热电偶 A、B 的热电势			,称为		。导位	本 C 通
常用		制作。(两端温度;等于另外	·两个热电	1偶热电动势2	之差;标准电标	及定律;	铂)	
	8.	标准化热电偶国家已定型批量生产	<sup>-</sup> 。同一	型号的具有良	好的	_,有统	一的	,
并有	.与.	之记录和显示仪表。(互换	性;分原	〔表; 配套)				
	9.	热电偶按本身结构形式划分有:_	热	电偶、	热电偶、	热电	电偶。(普	普通;
铠装	; }	薄膜)						
	10.	普通热电偶的热电极是		金属丝,两热	、电极之间		,为ī	了防止
有害	介	质侵蚀,工业上使用的热电偶一般	:都配有_	o	(一端焊接在-	一起两根	;用绝线	<b>录管绝</b>
缘;	保护	护套管)						
	11.	. 铠装热电偶是将、	,	:	组合在一起,组	经拉伸加	工而成监	区实的
组合	·体,	,该元件做得、	,易于_	适于狭	小地点的温度	测量。(	热电极;	绝缘
材料	; 1	保护套管;很细;很长;弯曲)						
	12.	薄膜热电偶是用真空蒸镀等工艺	将	材料沉积	在绝缘基片上	形成	而成。	它的
测量	端	既,适于	微小面积	尺上的温度测量	量。(热电极;	薄膜;	小,薄;	微小
面积	(上)	)						
	13.	热电偶的冷端处理方法有:		_`\	_法、	_法、	法	· (0°
恒温	ı; Ì	计算修正; 电桥补偿; 冷端延长)						
	14.	. 0℃ 恒温法是将热电偶的	里入	的	呆温瓶中。该法	是一个_		<b></b> 该高的
方法	;, 1	但是只适用于。(冷端;	0℃冰水	混合物;准确	度;实验室)			
	15.	. 计算修正法是热电偶的冷端温度	保持在基	其一温度 tn条	件下,热端温	度为 t 时	,测得热	热电势

是
用
+E(t <sub>n</sub> , 0); E(t, 0); 分度表)
16. 电桥补偿法是当热电偶冷端温度变化时,对热电偶回路提供一个,其大小
与因引起的变化相等,而相反,达到自动补偿的目的,从而保
证不变。电桥补偿法是利用电桥的输出电压,自动地补偿热电偶因变
化而引起的变化。(附加电动势;回路热电动势;冷端 tx变化;方向;热电回路输出;
不平衡;冷端温度 tx; 热电动势)
17. 冷端延长法是将
冷端引到、的地点去。当用于延长的电极的与原来电极在低温区段的
时,就不会影响测量结果。当然,冷端延长法既不能使冷端温度,对热电偶回路内的热电势也
。(热电极(昂贵的热电极);热电性能相近的导线(廉价的热电极);低温;变化小;热电特性
热电特性相同或相近;恒0℃;不能起温度补偿)
1. 金属导体和半导体有个显著差别在于金属的电阻率随
的电阻率随(少数除外)。(温度升高;增加;温度升高;减小)
2. 热敏电阻是利用半导体的
大)
3. 半导体中导电的是, 其数目比金属中自由电子数目, 故其大。温
度升高后,载流子数目的增加随温度以上升,半导体的电阻率也就随温度以下
降。(载流子;少得多;电阻率;指数规律;指数规律)
4. 热敏电阻的与的关系称热电特性,它近似符合规律。(阻值;温度
指数函数)
5. 随着温度的升高,电阻率减小的电阻,称缓变型热敏电阻。
由某些的混合物制成。(随温度升高;负温度系数;固体多晶半导体氧化物)
6. 电阻率随温度的升高而增加,但过某一温度后的电阻,称剧变型
热敏电阻。该类电阻材料是,在室温下是半导体,所以又叫。(急剧增加;正温
度系数; 陶瓷; 半导体陶瓷)
7. 当温度接近某一数值时,电阻率产生的电阻,称热敏电阻,它是钒,钡,
磷和硫化银系。(突变下降;临界;混合氧化物;烧结
体)
8. 利用热敏电阻测量,控温或温度补偿时,

的
(测量电流;线性;环境温度;热)
9. 剧变型和临界型热敏电阻不能用于范围内的,但用于某一范围内的
制却是十分优良的。(宽; 温度控制; 窄; 温度)
第八章
1. 气敏元件属于以化学物质为检测参数的化学敏感元件。(成分)
2. 气敏材料是,常温下是体。合成时,通过的偏移和
杂质缺陷制成 N 型或 P 型半导体电阻。(金属氧化物;绝缘;化学计量比)
3. 气敏电阻接触被测气体时,产生的
使气敏电阻发生变化,从而感知被测气体。(化学吸附;浓度;数值)
4. 气敏电阻常温下吸附气体主要是。为了达到气敏电阻的,需要对元
件本身加热到适当温度,所以气敏元件多数自备。(物理吸附;化学吸附;电阻
加热器)
5. 气敏电阻种类很多,按制造工艺上分,主要有,,和。他们大多数
工作在以上,少数工作在常温。(烧结型;薄膜型;厚膜型;200℃)
6. 烧结型气敏元件是将元件的和均埋在气敏材料中,经加压成
型后低温而成。(电极;加热器;金属氧化物;烧结)
7. 薄膜型气敏元件是在石英或陶瓷的上,采用真空镀膜或溅射方法制成
膜而成。(基片;金属氧化物)
8. 厚膜型气敏元件是将气敏材料与一定比例的硅凝胶混合成能够印刷用的,再把它
用丝网印刷到已安放铂电极的氧化铝上,经干燥烧结而成。(厚膜胶;基片)
9. 用气敏电阻元件的基本测量电路中有两个电源,一个用于;另一个用于。(加
热;测量)
第九章
1.湿敏电阻是一种随环境的变化而变化的元件。它由,电极
和组成。(阻值;相对湿度;湿敏;感湿层;绝缘基片)
2. 湿敏电阻的感湿层,在吸收了后引起了两极间的变化。这样就能直
接将的变化转换成的变化。(环境中的水份; 电阻; 相对湿度; 电阻值)
3. 氯化锂是一种类材料。将它涂在上,或用性合成树脂材料浸
透氯化锂,就构成氯化锂湿敏电阻。(吸湿性盐;有机绝缘基片;多孔)

答:在置于磁场的导体或半导体中通入电流,若电流与磁场垂直,则在与磁场和电流都垂直的方向上会出现一个电势差,这种现象就是霍尔效应,是由科学家爱德文·霍尔在1879年发现的。产生的电势差称为霍尔电压。

# 2.. 为什么霍尔元件一般采用 N 型半导体材料?

答: 因为在 N 型半导体材料中,电子的迁移率比空穴的大,且  $\mu_n > \mu_p$ ,所以霍尔元件一般采用 N 型 半导体材料。

# 3. 霍尔灵敏度与霍尔元件厚度之间有什么关系?

答: 霍尔灵敏度与霍尔元件厚度成反比,  $K_H = \frac{1}{nqd}$  。

# 4. 集成霍尔传感器有什么特点?

答:集成霍尔传感器的特点主要是取消了传感器和测量电路之间的界限,实现了材料、元件、电路三位一体。集成霍尔传感器与分立相比,由于减少了焊点,因此显著地提高了可靠性。此外,它具有体积小、重量轻、功耗低等优点。

# 5. 写出你认为可以用霍尔传感器来检测的物理量。

答:可以用霍尔传感器来检测的物理量有力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、转速、磁场量等等。

1. 当磁场中静止载流导体的方向与不一致时,的平行于和方向
上的两个面上产生的现象称为霍尔效应。它是导体中的再磁场中受到
作用发生的结果。(电流;磁场;栽流导体;电流;磁场;电动势;载流子;洛仑兹力;
横向漂移)
2. 霍尔元件是型半导体制成形状的敏元件。(N; 扁平长; 磁)
3. 当霍尔元件处于中,且方向与霍尔元件方向一致时,霍尔电势
与和。(均匀磁场;磁场;扁平
面法线;激励电流;磁感应强度;U <sub>H</sub> =K <sub>H</sub> BI)
4. 霍尔元件的灵敏度表示在
小。它与半导体材料的和霍尔片的成反比。(单位激励电流;单位磁感应强度;霍尔
电势; 电荷密度; d)
5. 霍尔元件外部有两对电极。一对用来施加, 叫电极;另一对用来引
出霍尔电势,叫电极。(激励电流;控制;霍尔电势;霍尔)
6. 霍尔常数 RH 的大小与导体的载流子密度成反比。金属因自由电子而不宜
制作霍尔元件。霍尔电势与导体成反比,因而霍尔元件制作成
密度大于半导体;厚度;薄片)
9. 霍尔元件是材料制成的,因而其有关量和参数都随温度的变化而,使
霍尔式传感器有误差。减少该误差的措施有:用供电,减少由于随温

度变化引起的误差;用激励电极电阻,减少由
(半导体;变化;温度;恒流源;输入电阻;并联分流;灵敏系数)
12.两个P <sup>+</sup> 和 N <sup>+</sup> 型半导体,中间用,一侧有的近本征半导
体 i 区连接组成磁敏二极管。(不接触;低杂质高电阻;高复合区)
13. 磁敏三极管有三个结(、、、、)。有发射区 N <sup>+</sup> ,集电区 N <sup>+</sup> ,
和基区 P+,中间用较长的半导体 i 区连接而成。在 i 区靠近发射结的侧面建立。
(集电结;发射结;基极结;近本征;复合区r)
14. 磁敏三极管中的
射极电流大部分形成电流,小部分形成电流。在正向或反向磁场作用下,引起集
电极电流的增加或减少。用磁场的方向控制集电极电流的
集电极电流的变化量。(发射;基;基极;集电极;增加;减少;强弱)
15. 磁敏三极管的灵敏度比二极管大倍到倍,其工作电压的范围也较宽。(几;十
几)
第十一章
$L$ 有一直线光栅,每毫米刻线数为 100,主光栅与指示光栅的夹角 $\theta$ =1.8°,则:分辨力(栅距
W)=? 莫尔条纹的宽度=?
分辨力 $\Delta$ =栅距 W =1mm/100=0.01mm=10 $\mu$ m
莫尔条纹的宽度 $L \approx W/\theta = 0.01$ mm/(1.8°*3.14/180°)
= 0.01 mm/0.0314 = 0.318 mm
2.有一增量式光电编码器,其参数为 1024p/r, 在 5s 时间内测得 65536 个脉冲,则转速
(r/min)为 ?
解: $n = 60 \times 65536 / (1024 \times 5)$ r/min
= 768 r/min
光栅传感器的结构
光栅传感器的结构
莫尔条纹的性质
旋转角编码器的分类
感应同步器的种类
磁栅的工作原理和结构
磁头
第十二章

光纤传感器分类、数值孔径

第十三章

静态标定和动态标定

第十四章

检测信号放大器种类,要求 隔离放大器作用 模拟和数字滤波器滤波器种类 非线性校正方法 信号变换中统一标准信号 采用直流电流传送的优点

第十五章

自动化仪表的分类及组成 自动化仪表的硬件部分 自动化仪表的基本功能和特点 自动化仪表设计研制步骤 自动化仪表监控程序主要任务和监控主程序 干扰进入仪表的主要途径和分类

第十六章

虚拟仪器的构成、虚拟仪器软件